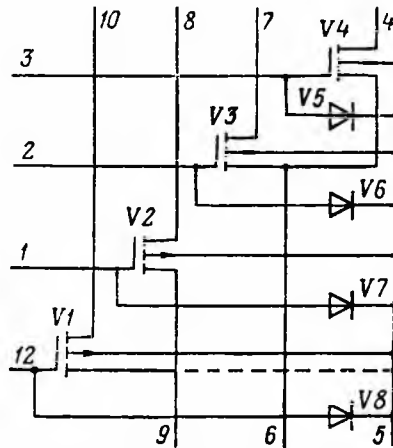


190КТ2, К190КТ2

Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуцированным каналом *p*-типа. Предназначены для коммутации электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом корпусе типа 201.14-1 (серия К190).

Микросхемы используются как четырехканальный коммутатор.



Принципиальные схемы ИМС 190КТ2, К190КТ2

Параметры	Режим измерения	190КТ2
		К190КТ2
$U_{зи\text{ пор}}$, В	$U_{ип} = 0; I_c = 10 \text{ мкА}, U_{си} = -5 \text{ В}$	-6
$I_{з\text{ ут}}$, нА	$U_{зи} = -30 \text{ В}; U_{си} = U_{ип} = 0$	≤ 30
		≤ 50
$I_{с\text{ нач}}$, нА	$U_{ип} = U_{зи} = 0; U_{си} = -25 \text{ В}$	≤ 400
$I_{п}$, нА	$U_{ип} = 25 \text{ В}$	≤ 150
$R_{отк}$, Ом	$U_{зи} = -20 \text{ В}, U_{ип} = 0; I_c = 1 \text{ мА}$	≤ 50
$R_{отк}$, Ом	$U_{зи} = -10 \text{ В}; U_{ип} = 0; I_c = 1 \text{ мА}$	≤ 120
$C_{11и}$, пФ	$U_{си} = -15 \text{ В}; U_{ип} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	≤ 24
$C_{12и}$, пФ	$U_{си} = -15 \text{ В}; U_{ип} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	≤ 9
$C_{22и}$, пФ	$U_{си} = -15 \text{ В}; U_{ип} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	15

¹ При температуре $25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации указаны в следующей таблице.

$U_{си}$, В	$U_{зи}$, В	$U_{зс}$, В	$U_{ип}$, В	$U_{зп}$, В	I_c , мА	$P_{рас\text{ макс}}$, мВт
-25	-30	-30	25	-30	10^1	200

¹ Для микросхемы 190КТ1, для ИМС 190КТ2 $I_{с\text{ макс}} = 50 \text{ мА}$.